

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ. ТРАНЗИСТОРОВ:

золото - 0.000074 г  
в том числе 0.000074 г  
в том числе 0.000074 г  
золото - г/мм на 4 выводах длиной (23 ± 1) мм

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа 2П350Б, 2П350В соответствуют техническим условиям 3.365.215-79 от 09.03.1990 г.

1379

Приняты по извещению № от 11 АИ 1990 г. дата

Штамп ОТК 06-50

Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена \_\_\_\_\_ дата

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ дата

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Штамп представителя заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Основное назначение транзистора - усиление, генерирование и преобразование высокочастотных сигналов в диапазоне частот до 700 МГц.

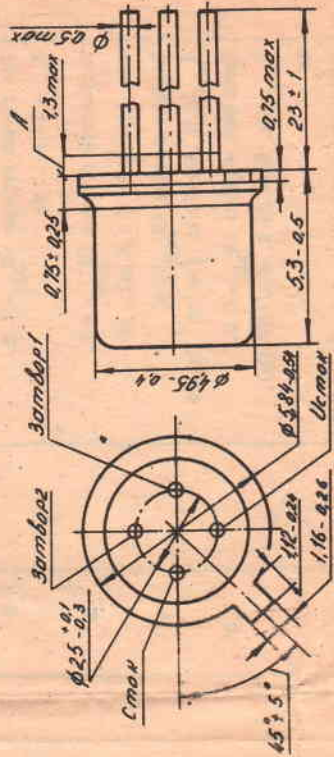
Использование транзисторов типа 2П350А разрешается при работе на частотах не менее 200 МГц.

ТРАНЗИСТОРЫ 2П350А, 2П350В

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые планарные полевые с двумя изолированными затворами с п-каналом транзисторы 2П350А, 2П350В в металlostеклянном корпусе, предназначенные для работы в приемной, усилительной аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ



В зоне А размеры выводов не регламентированы

Масса не более 0,7 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
(при  $T$  окр. ср. =  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ )

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Круговая характеристика ( $I_{з2}$ ) $I_{ох} = 10 \text{ В}$ , $I_{с} = 10 \text{ мА}$ , $f = 50 \dots 1500 \text{ Гц}$ , мА/В	6	
Начальный ток стока ( $I_{ох} = 15 \text{ В}$ ), мА		3,5
Ток утечки затвора ( $I_{з1}$ ) $I_{з2} = 15 \text{ В}$ , мА		5
Напряжение отсечки ( $I_{з2}$ ) $I_{ох} = 15 \text{ В}$ , $I_{с} = 0,1 \text{ мА}$ , В		6
Входная емкость ( $I_{з1}$ ) $I_{з2} = 0 \text{ В}$ , $I_{ох} = 10 \text{ В}$ , $f = 1 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ , пФ		6
Проходная емкость ( $I_{з1}$ ) $I_{з2} = 0 \text{ В}$ , $I_{ох} = 10 \text{ В}$ , $f = 1 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ , пФ		0,07
Выходная емкость ( $I_{з1}$ ) $I_{ох} = 10 \text{ В}$ , $f = 1 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ , пФ		6
Коэффициент шума ( $I_{з2}$ ) $I_{с} = 10 \text{ мА}$ , $f = 4 \cdot 10^8 \text{ Гц}$ , дБ		6
$I_{з2} = 6 \text{ В}$ , $I_{ох} = 10 \text{ В}$ , $I_{с} = 10 \text{ мА}$ , $f = 1 \cdot 10^8 \text{ Гц}$ , дБ		6
2П350 Б		6

2. Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаками (в 3...4 слоя) типа УР-231 по ТУ 6-10-863-84, ЭП-730 по ГОСТ 20824-81 с последующей подсушкой.

При эксплуатации в условиях воздействия ионизации должна быть обеспечена защита транзистора от непосредственного влияния путем применения общей герметизации блоков и узлов аппаратуры покрытием плат влагозащитными лаками. Принятые меры не должны ухудшать параметры транзисторов.

3. При работе с транзисторами необходимо применение мер защиты от воздействия статического электричества согласно ГОСТ II 073.062-84.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

4. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм, при изгибе усилие не должно передаваться на стеклотермостой.

5. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора.

Рекомендуемый типовой режим пайки: паяльник мощностью не более 60 Вт с напряжением 6...12 В, время пайки не более 3 с, температура пайки  $(260 \pm 10)^\circ\text{C}$ . При пайке жало паяльника должно быть заземлено.

Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более, чем на 3 с в расплавленный припой с температурой  $(260 \pm 10)^\circ\text{C}$ .

Перед погружением в припой выводы промывают спиртом, а затем смачивают флюсом (состав флюса: 10...40 % канифоли, 90...60 % спирта); припой ПОС-61.

При пайке обязательно применение мер защиты корпуса транзистора от попадания флюса и припоя. В момент пайки все выводы транзистора должны быть закорочены.

6. Не допускается использовать транзистор в совмещенных пределах допустимых электрических и температурных режимах.

7. Схемы, содержащие полые транзисторы с изолированным затвором, можно проверять заданными токами приборами (омеетрами), только закоротив предварительно все выводы каждого транзистора.

8. При влажности до 98 % и температуре до  $40^\circ\text{C}$ , морском и тропическом климате с целью обеспечения тока утечки затвора на уровне не выше  $5 \cdot 10^{-9} \text{ А}$ , необходимо использовать транзисторы в составе герметизированной аппаратуры или при местной защите транзисторов от воздействия влаги.